



汕头华汕电子器件有限公司

NPN SILICON TRANSISTOR

H2682

对应国外型号
2SC2682

主要用途

作音频功率放大。

极限值 ($T_a=25$)

T_{stg} ——贮存温度.....	-55~150
T_j ——结温.....	150
P_C ——集电极功率耗散 ($T_c=25$)	8W
P_C ——集电极功率耗散 ($T_A=25$)	1.2W
V_{CBO} ——集电极—基极电压.....	180V
V_{CEO} ——集电极—发射极电压.....	180V
V_{EBO} ——发射极—基极电压.....	5V
I_C ——集电极电流.....	100mA

外形图及引脚排列



电参数 ($T_a=25$)

参数符号	符号说明	最小值	典型值	最大值	单位	测试条件
I_{CBO}	集电极—基极截止电流			1	μA	$V_{CB}=180V, I_E=0$
I_{EBO}	发射极—基极截止电流			1	μA	$V_{EB}=3V, I_C=0$
$h_{FE}(1)$	直流电流增益	90	190			$V_{CE}=5V, I_C=1mA$
$h_{FE}(2)$		100		320		$V_{CE}=5V, I_C=10mA$
$V_{CE(sat)}$	集电极—发射极饱和压降		0.12	0.5	V	$I_C=50mA, I_B=5mA$
$V_{BE(sat)}$	基极—发射极饱和压降		0.8	1.5	V	$I_C=50mA, I_B=5mA$
BV_{CBO}	集电极—基极击穿电压	180			V	$I_C=100\mu A, I_E=0$
BV_{CEO}	集电极—发射极击穿电压	180			V	$I_C=1mA, I_B=0$
BV_{EBO}	集电极—基极击穿电压	5			V	$I_E=10\mu A, I_C=0$
f_T	特征频率		200		MHZ	$V_{CE}=10V, I_C=20mA$
C_{ob}	输出电容		3.2	5.0	pF	$V_{CB}=10V, I_E=0, f=1MHz$

分档及其标志

0	Y
100—200	160—320